グラファイト状窒化炭素で修飾した水晶振動子の水素ガスセンサ特性

Hydrogen-gas sensor characteristics of quartz crystal microbalance with graphitic carbon nitride modified substrate

○石黒 康志¹, 西谷 平¹, Can Li², 平栗 健二¹

Email: ishiguroy@mail.dendai.ac.jp

1東京電機大、2中国計量大



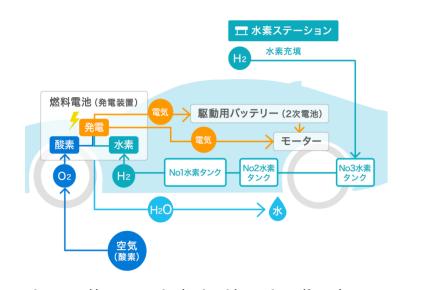
東京電機大学

研究背景

水素の将来性

近年の脱炭素化の流れにより クリーンエネルギー源として 水素が注目

燃料電池自動車



https://toyota.jp/mirai/station/faq/

燃料電池航空機・鉄道、 水素発電、etc.

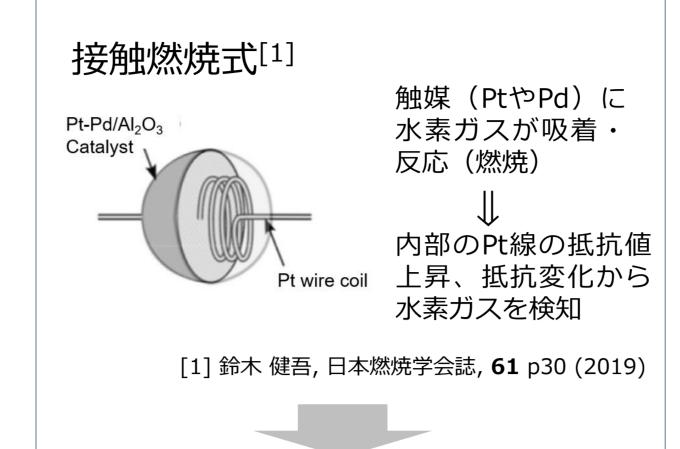
水素の性質

項目	水素	メタン
爆発濃度範囲 (vol%)	4.0 ~ 75.0	5 ~ 15
最小着火エネ ルギー (mJ)	0.02	0.28
拡散係数 (m²/s)	6.1	1.6

漏えいしやすく、燃焼しやすい

安全な水素社会の実現: 水素漏れを検知する水素ガス センサの需要大

従来の水素ガスセンサ



欠点:

動作に高温が必要、材料に 高価な貴金属が必要

本研究で目指すセンサ:

貴金属を用いずに室温動作する水素ガスセンサ

材料:グラファイト状窒化炭素 (grahitic-carbon nitride: g-C₃N₄)

特徴:

センサ構造:水晶振動子マイクロ

n型半導体、 光触媒特性 etc.



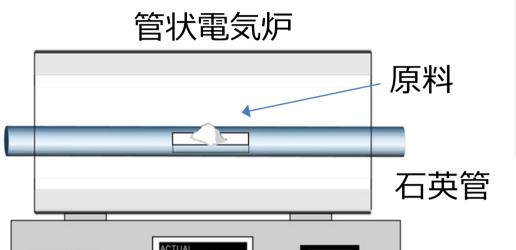
吸着エネルギー: -0.94 eV

弱く(物理)吸着

[2] S. Luo et al., Vacuum, **200**, 111014 (2022)

実験方法

g-C₃N₄粉末の合成方法



温度制御器

 $(C_2H_4N_4)$ ·加熱時間:600°C,3 h

・原料:ジシアンジアミド

・昇温速度:4°C/min ・雰囲気:大気下

合成したg-C₃N₄粉末の写真

➤ g-C₃N₄薄膜の製膜方法

2h真空乾燥

①メタノール中にg-C₃N₄を分散 (超音波処理 1 h) ②洗浄した基板上に分散液を滴下 ③ホットプレート上で100°C, 15 min加熱 ④真空チャンバー内で60°C,

バランス (QCM) 水素ガス



電極上に製膜した膜にガス分子が吸着

➡ 電極の質量変化 ➡ 水晶の共振周波数が変化、 ガス分子を検知

> g-C₃N₄上へのH₂吸着メカニズムの考察

After H₂

introduction

36.8

31.5

31.7

1.17

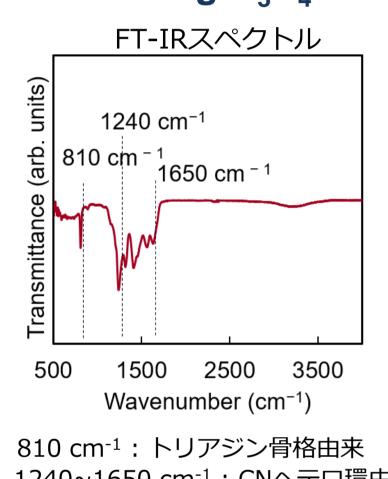
周波数が減少:質量増加 [3] G. Li et al., Sensors, 7, 2378 (2007)

本研究の目的

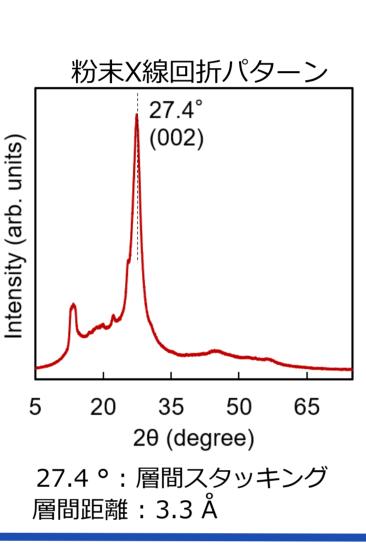
QCM電極上にg-C3N4膜を 製膜、評価

- ·g-C₃N₄膜上へのH₂分子 の吸着特性を解明
- 室温動作する水素センサ としての特性を解明

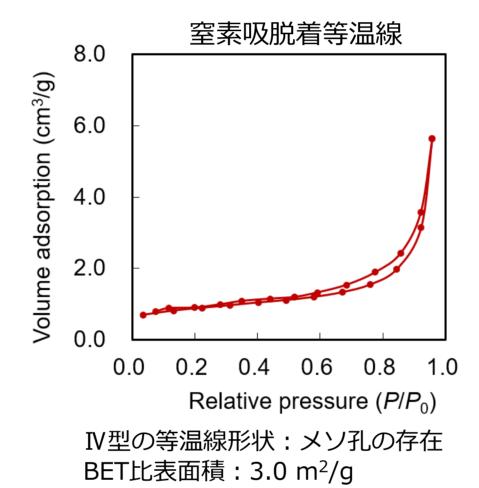
合成したg-C₃N₄の物性

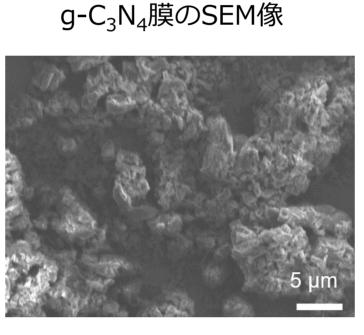


1240~1650 cm⁻¹: CNヘテロ環由来



8.0 6.0





数µmオーダーの凝集を確認

▶ ガスセンサ評価装置の概要 QCM測定チャンバ ᡎ H₂ ガスライン マスフロー コントローラー 混合ガス N₂ ガスライン 電気抵抗測定チャンバ ガス混合 マスフロー コントローラー

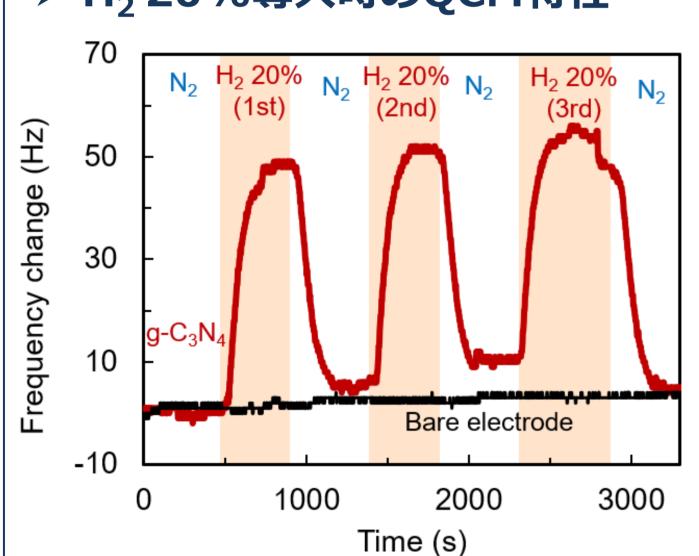
キャリアガス: N₂(≥99.99%), 50 mL/min

- H_2 : $\geq 99.9999\%$ purity
- ・チャンバー温度:23 °C ・水晶板:固有周波数 9 MHz
- 電極径 Φ 5 mm
- ・電気抵抗測定:くし型電極 (Au) 製膜後のQCM電極の写真



結果・考察

➤ H₂20%導入時のQCM特性



g-C₃N₄で修飾したQCM電極 Hっガスに反応 → H₂導入で共振周波数増加

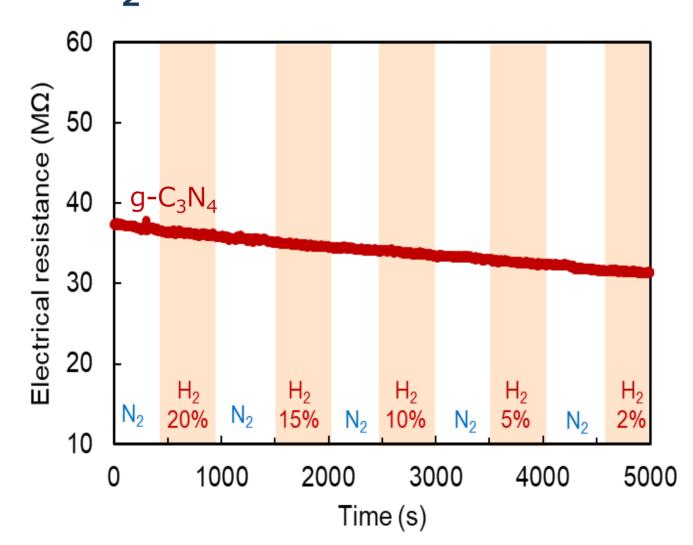
未修飾のQCM電極 H₂ガスに反応なし

g-C₃N₄膜上にH₂が吸着

▶ 様々なH₂濃度でのQCM特性

 $g-C_3N_4$

> H₂ 導入時の電気抵抗変化



g-C₃N₄膜の電気抵抗 H₂ガスに反応なし

吸着した水素:g-C₃N₄の電子構造 への影響少

g-C₃N₄膜をQCM電極へ適用:

室温で水素検出が可能

H₂濃度と周波数変化量の相関

 $R^2 = 0.991$

H₂導入によってC-N=Cを構成する

N原子の脱離を示唆

N1s narrowスペクトル変化:

H₂導入時のQCM特性:

H₂導入前後のXPSによる組成分析

(Surveyスペクトルから算出した原子濃度)

Before H₂

introduction

36.5

37.4

0.96

H₂導入によってN原子の割合が減少

(実験結果と理論計算[5]からの予想)

g-C₃N₄のC-N=C結合中のN原子上に水素が段階的に結合

NH₃を形成後脱離。質量が軽くなり周波数が増加

脱離後の欠陥にNが入り質量増加、周波数が元に戻る

H₂導入前 H₂導入後 g-C₃N₄のN原子上への水素吸着、NH₃脱離過程のエネルギー状態 [5]

H₂導入前後の

N1s narrowスペクトル

 H_2 導入で共振周波数増加 = 電極質量が減少 = $g-C_3N_4$ 膜から何かが脱離

H₂導入前後の Tauc プロットと粉末X線回折パターン

Before H₂ introduction

H₂導入後も光学特性やバンドギャップ、 結晶構造に大きな変化無し

H₂導入によって起きている現象

[5] L. Liu et al., J. Mater. Chem. A, 9, 27518 (2021)

そのN上に3個目の $g-C_3N_4$ *H $g-C_3N_4$ * H_2 $g-C_3N_{4-}$ $g-C_3N_4*H_3$ **Reaction coordinate**

異なる原料(メラミン C₃H₆N₆)で合成したg-C₃N₄のQCM特性

- ・g-C₃N₄は様々な原料から合成可能
- ・原料の種類によって得られるg-C₃N₄ の特性も多少変化

合成したg-C₃N₄の 比表面積 (m²/g) ジシアンジアミド メラミン 15.5 メラミンを用いることで比表面積:増

H₂導入時のQCM特性 H₂導入により周波数が増加 H₂導入前後のXPSによる組成分析 (原子濃度)

> Before H₂ introduction introduction 35.5 1.07

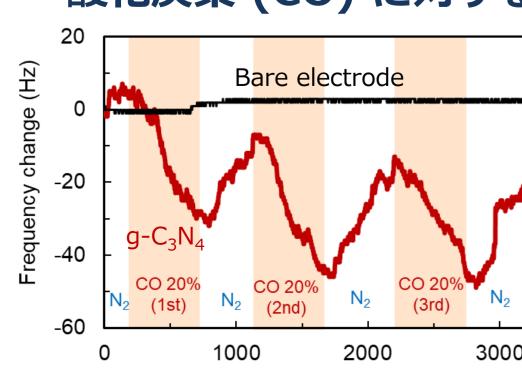
H₂導入によりN原子の割合が減少

H₂導入による窒素脱離現象:原料に依存せず、g-C₃N₄に共通して発生

➤ 一酸化炭素 (CO) に対するQCM特性

Time (s)

H₂濃度に応じて周波数変化量も変化



理論計算[4] 吸着エネルギー: -0.41 eV g-C₃N₄上にCOも弱く (物理)吸着する

H₂ concentration (%)

水素センサとして有用

水素濃度に対する変化量の線形性:

[4] H. Basharnavaz et al., Phys. Lett. A, **383**, 21 (2019)

g-C₃N₄で修飾したQCM電極

- COガスに反応 → CO導入で周波数減少 Hっのときとは逆の周波数変化
- Time (s) CO導入時のQCM特性: CO導入 → g-C₃N₄上に吸着、電極の質量増加 → 共振周波数の減少

「まとめ

- g-C₃N₄をQCM電極上に製膜することで、室温で水素ガスセンサ動作を実現 (従来型の水素センサのような高温動作や貴金属触媒が不要)
- ・g-C₃N₄の原料に依存せず、H₂検出動作を確認
- ・H₂検出原理は水素吸着後にNが脱離することで周波数が減少している可能性

展望:排出ガス成分の分析によるH₂検出原理の解明、比表面積と水素検出感度の相関性の解明